Silicon PIN Diode

BA679

30V / 50mA

DATASHEET

OEM – Telefunken

Source: Telefunken Databook 1988

BA 679 · BA 679 S

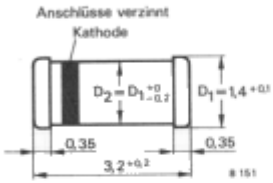
Silizium-PIN-Dioden

Anwendungen: Stromgesteuerter HF-Widerstand in regelbaren Netzwerken

Besondere Merkmale:

- Großer Frequenzbereich 10 MHz…1 GHz

Abmessungen in mm



Glasgehäuse
SOD 80
Mini MELF
Gewicht max. 0,1 g

Absolute Grenzdaten

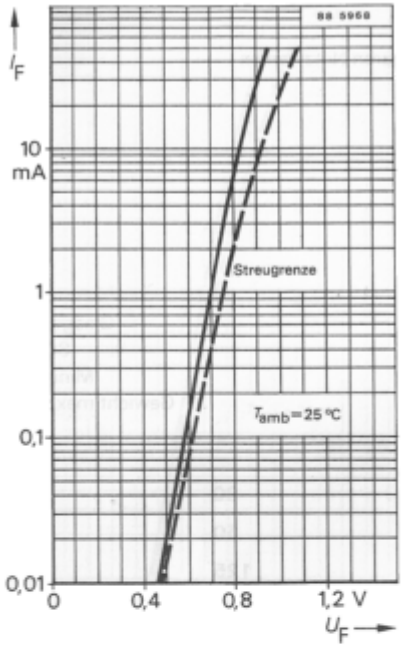
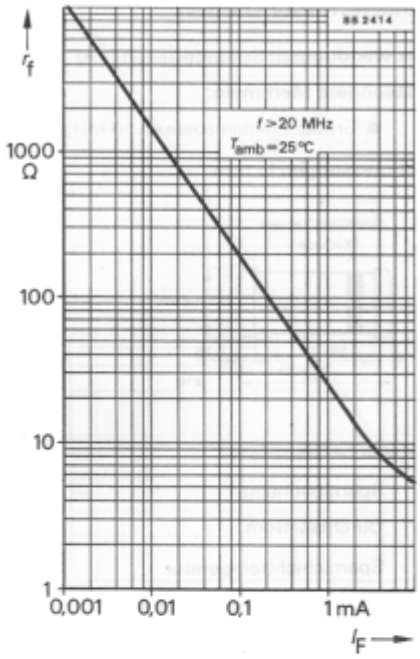
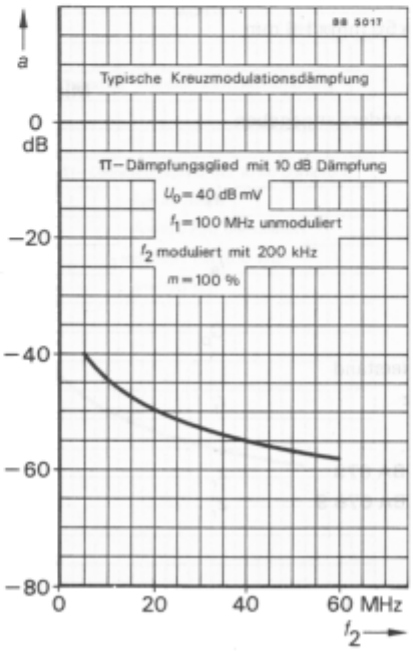
Sperrspannung	U_R	30	V
Durchlaßstrom	I_F	50	mA
Sperrschichttemperatur	T_j	125	°C
Lagerungstemperaturbereich	T_{stg}	– 55 ….+ 125	°C

Maximaler Wärmewiderstand

Sperrschicht-Umgebung auf Leiterplatte 50 mm x 50 mm x 1,6 mm	R_{thJA}	500	K/W

Kenngrößen

T_{amb} = 25 °C, falls nicht anders angegeben

			Min.	Typ.	Max.	
Durchlaßspannung I_F = 20 mA		U_F			1	V
Sperrstrom U_R = 30 V		I_R			50	nA
Diodenkapazität U_R = 0, f = 100 MHz		C_D			0,5	pF
Differentieller Durchlaßwiderstand I_F = 1,5 mA, f = 100 MHz		r_f			50	Ω
Sperrimpedanz U_R = 0, f = 100 MHz	**BA 679**	z_r	5			kΩ
	BA 679 S	z_r	9			kΩ

BA 679 · BA 679 S